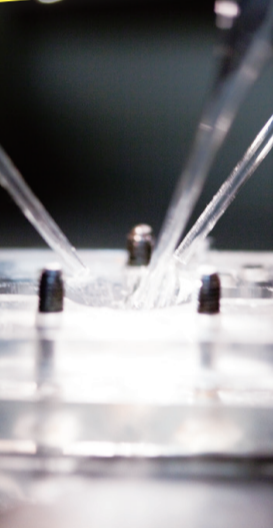
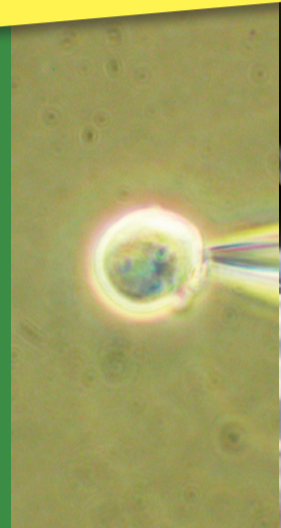
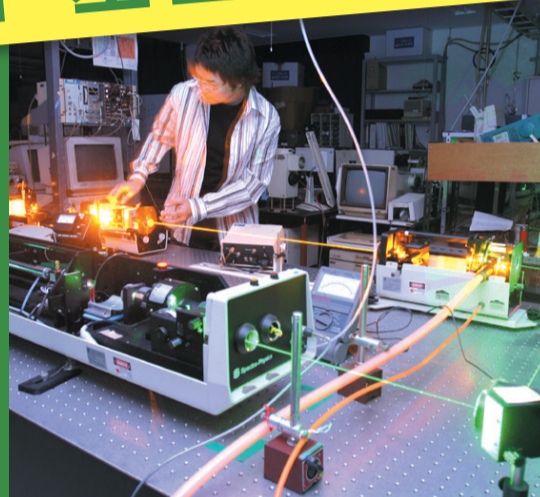
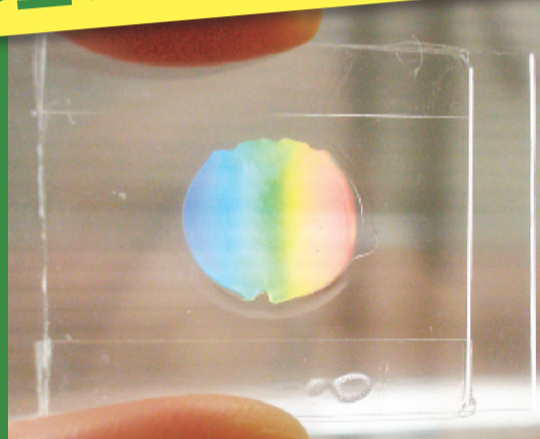


電気通信大学院

基盤技術が最先端を創る!

情報理工学研究科 基盤理工学専攻



電子工学 プログラム

- ▶ 半導体材料
- ▶ シリコンフォトンクス
- ▶ 原子レベル物質設計
- ▶ 超伝導デバイス
- ▶ ナノテクノロジー など
- ▶ 半導体量子構造
- ▶ 燃料電池

光工学 プログラム

- ▶ レーザー
- ▶ ナノフォトンクス・光機能材料
- ▶ 光情報・通信
- ▶ 極限光計測・イメージング
- ▶ 画像・ディスプレイ
- ▶ 量子光工学 など

物理学 プログラム

- ▶ 量子物性
- ▶ レーザー冷却
- ▶ ボース・アインシュタイン凝縮体
- ▶ ナノトライボロジー
- ▶ メタマテリアル など
- ▶ 光物性
- ▶ 多価イオン
- ▶ 超高速原子・分子分光
- ▶ 超伝導

化学生命工学 プログラム

- ▶ 生体機能科学
- ▶ イメージング・医療技術革新
- ▶ 自己組織化・超分子・複雑系
- ▶ フラーレン新素材
- ▶ ナノ材料 など
- ▶ 神経科学
- ▶ 電子・光・磁気機能材料

◎ オープンイノベーションプログラム (博士前期・後期5年一貫教育) 設置

学生募集要項 (平成30年4月入学、平成29年10月入学)

博士前期課程 募集人員

135名

	[7月入試] 推薦入試	[8月入試] 一般入試・社会人入試
募集人員	54名	81名
出願期間	平成29年6月12日(月) ～6月15日(木)	平成29年7月21日(金) ～7月27日(木)
試験期日	7月3日(月)	8月17日(木)・18日(金)
合格発表	7月14日(金)	9月7日(木)

博士後期課程 募集人員

16名

	[8月入試] 一般入試・社会人入試	[2月入試] 一般入試・社会人入試
募集人員	16名	若干名
出願期間	平成29年7月21日(金) ～7月27日(木)	平成30年1月5日(金) ～1月10日(水)
試験期日	8月21日(月)	2月1日(木)
合格発表	9月7日(木)	2月26日(月)

※ [博士前期課程] 平成29年10月入学の一般入試(外国人留学生のみ対象)は8月入試で実施。[博士後期課程] 平成29年10月入学の一般入試・社会人入試は8月入試で実施。詳細は入試課までお問い合わせ下さい。

ラボサーチ
(研究室検索サイト)
基盤理工学専攻の
研究室をチェックしよう。

研究室見学
【学外生】受付中
見学日程は4月～6月の期間で個別に教員と
調整でき、大学院説明会等の日に限りません。

大学院オープンラボ
6/3(土)開催
専攻別説明、研究室公開等を行います。参加を希望
する学外生の方はWebから事前申込してください。

